

# 2SA755

シリコン PNP 三重拡散形

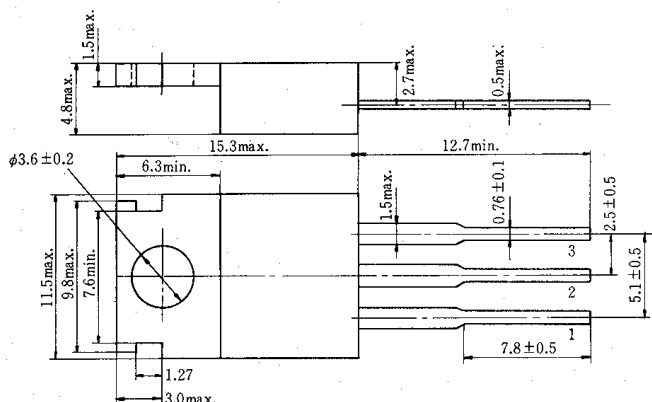
低周波電力増幅用

2SC1419とコンプリメンタリペア

SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SC1419



1. ベース : Base
  2. コレクタ : Collector  
(フランジ) (Flange)
  3. エミッタ : Emitter
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-220AB)

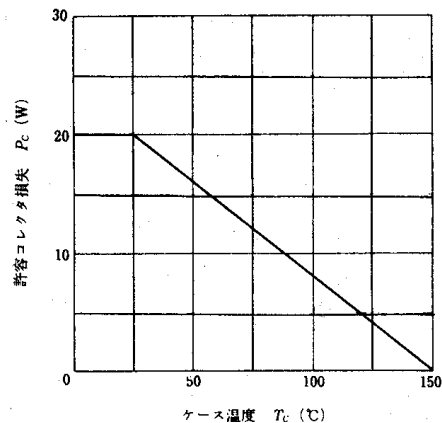
## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

| 項           | 目 | Symbol    | 2SA755     | Unit             |
|-------------|---|-----------|------------|------------------|
| コレクタ・ベース電圧  |   | $V_{CBO}$ | -50        | V                |
| コレクタ・エミッタ電圧 |   | $V_{CEO}$ | -50        | V                |
| エミッタ・ベース電圧  |   | $V_{EBO}$ | -4         | V                |
| コレクタ電流      |   | $I_C$     | -2         | A                |
| 許容コレクタ損失    |   | $P_C^*$   | 20         | W                |
| 接合部温度       |   | $T_j$     | 150        | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度        |   | $T_{stg}$ | -55 ~ +150 | $^\circ\text{C}$ |

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$  における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

| 項             | 目 | Symbol        | Test Condition                                      | min  | typ  | max  | Unit          |
|---------------|---|---------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|---------------|
| コレクタ・ベース破壊電圧  |   | $V_{(BR)CBO}$ | $I_C = -5\text{mA}, I_E = 0$                        | -50  | —    | —    | V             |
| コレクタ・エミッタ破壊電圧 |   | $V_{(BR)CEO}$ | $I_C = -50\text{mA}, R_{BE} = \infty$               | -50  | —    | —    | V             |
| エミッタ・ベース破壊電圧  |   | $V_{(BR)EBO}$ | $I_E = -5\text{mA}, I_C = 0$                        | -4   | —    | —    | V             |
| コレクタ遮断電流      |   | $I_{CBO}$     | $V_{CB} = -20\text{V}, I_E = 0$                     | —    | —    | -100 | $\mu\text{A}$ |
| 直流電流増幅率       |   | $h_{FE}^*$    | $V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -1\text{A}$             | 35   | —    | 200  |               |
| 直流電流増幅率       |   | $h_{FE}$      | $V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -0.1\text{A}$           | 35   | —    | —    |               |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 |   | $V_{CE(sat)}$ | $I_C = -1.5\text{A}, I_B = -0.15\text{A}$           | —    | —    | -1.3 | V             |
| ベース・エミッタ電圧    |   | $V_{BE}$      | $V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -1\text{A}$             | —    | -0.9 | -1.5 | V             |
| 2次破壊電流        |   | $I_M^{**}$    | $V_{CE} = -30\text{V}, f = 50\text{Hz (half wave)}$ | -2.0 | —    | —    | A             |
| 利得帯域幅積        |   | $f_T$         | $V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -0.5\text{A}$           | —    | 50   | —    | MHz           |

\* 2SA755は $h_{FE}$ の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

\* The 2AS755 is grouped by  $h_{FE}$  as follows.

| (A)   | (B)    | (C)     |
|-------|--------|---------|
| 35~70 | 60~120 | 100~200 |

\*\* 2次破壊時における電流で定義される。

\*\*  $I_M$  is defined as the current at which second breakdown occurs.